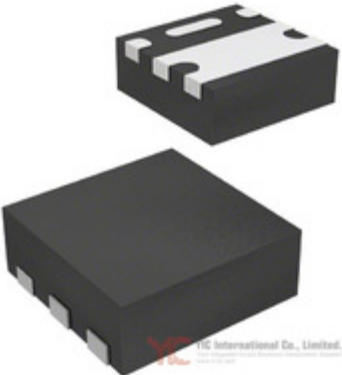

	<p>SIA106DJ-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA106DJ-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 60V POWERPAK SC-70</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SIA106DJ-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>





Spezifikationen

Teilenummer	SIA106DJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 60V POWERPAK SC-70
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18.5 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Andere Namen	SIA106DJ-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	540pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 10A (Ta), 12A (Tc) 3.5W (Ta), 19W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta), 12A (Tc)

SIA106DJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA106DJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA106DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA106DJ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA0903X01 SAMSUNG SAMSUNG QFP</p>	 <p>SIA3223-R15M DELTA DELTA 3223</p>	 <p>SIA402DJ-T1-E3 VISHAY SIA402DJ-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIA0902X01-AO SAMSUNG SAMSUNG DIP24</p>
 <p>SIA2206E02-HO SAMSUNG SAMSUNG DIP</p>	 <p>SIA400EDJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A SC-70</p>	 <p>SIA0903X01-007 TOSHIBA TOSHIBA QFP</p>	 <p>SIA400EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A SC-70</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA106DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / SIA106DJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA106DJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA106DJ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIA106DJ-T1-GE3
SIA106DJ-T1-GE3 Vishay	SIA106DJ-T1-GE3 Electronic	SIA106DJ-T1-GE3 Komponenten	SIA106DJ-T1-GE3-Verteiler
SIA106DJ-T1-GE3 Electronic	SIA106DJ-T1-GE3 Hersteller	SIA106DJ-T1-GE3 Bild	SIA106DJ-T1-GE3 Bild
SIA106DJ-T1-GE3 Preis	SIA106DJ-T1-GE3 Original	SIA106DJ-T1-GE3 garantiert	SIA106DJ-T1-GE3 RFQ
SIA106DJ-T1-GE3 Neu	SIA106DJ-T1-GE3 Original	SIA106DJ-T1-GE3 garantiert	SIA106DJ-T1-GE3 RFQ
SIA106DJ-T1-GE3 Neu	SIA106DJ-T1-GE3 Original	SIA106DJ-T1-GE3 garantiert	SIA106DJ-T1-GE3 RFQ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited